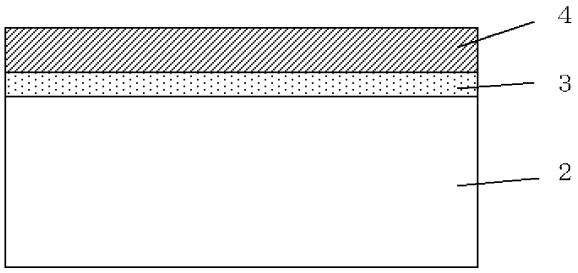
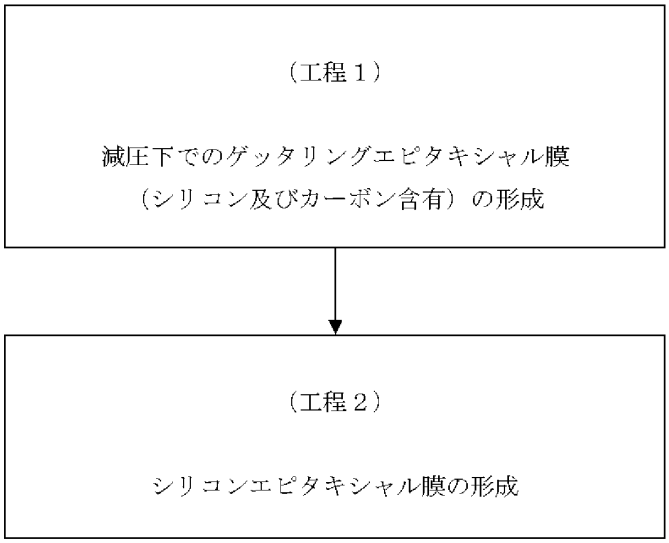
[図1]

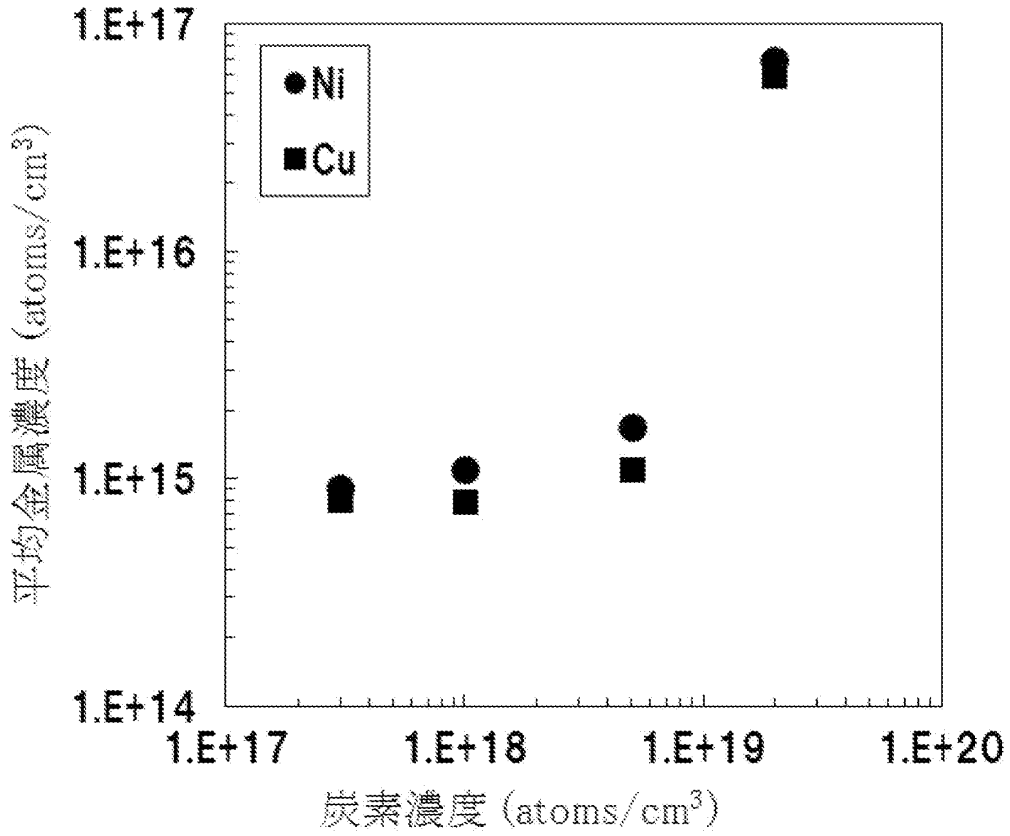
1


4
3
2

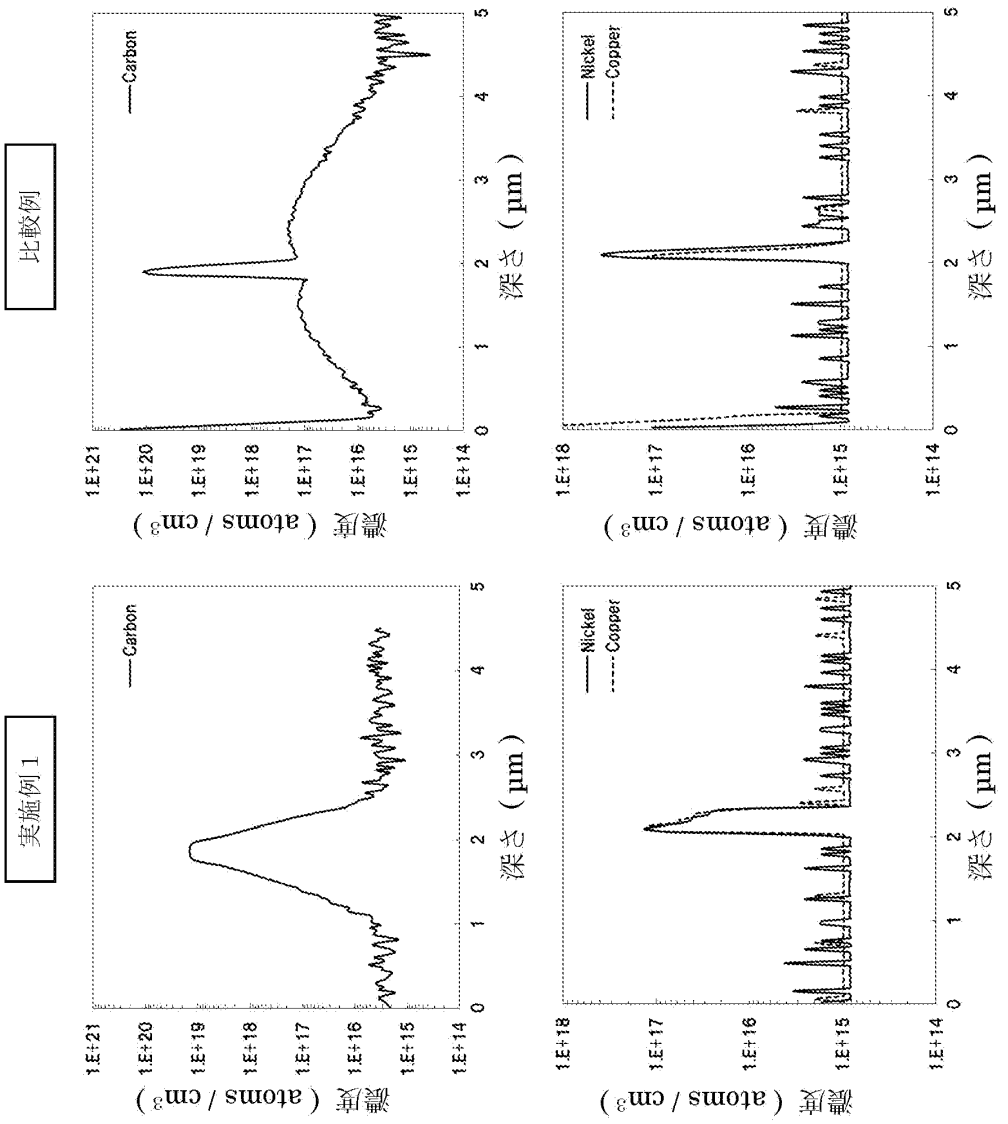
[図2]


（工程１）
減圧下でのゲッタリングエピタキシャル膜
（シリコン及びカーボン含有）の形成
（工程２）
シリコンエピタキシャル膜の形成

[図3]

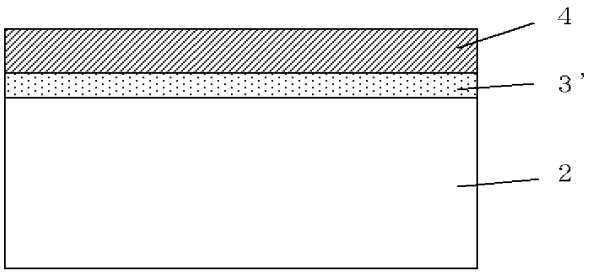

1.E+17
1.E+16
1.E+15
1.E+14
●Ni
■Cu
平均金属濃度 (atoms/cm3)
1.E+17
1.E+18
1.E+19
1.E+20
炭素濃度 (atoms/cm3)

[図4]

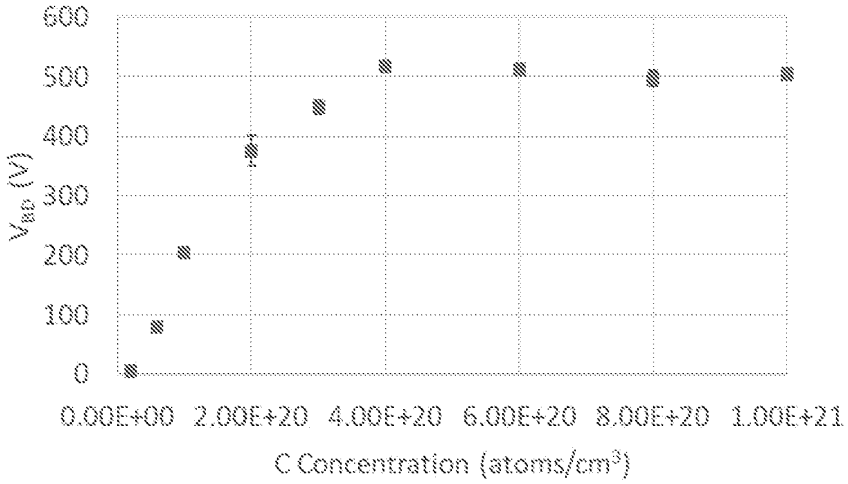

比較例
実施例1
Carbon
Nickel
Copper
濃度（atoms / cm3）
深さ（μm）
1.E+21
1.E+20
1.E+19
1.E+18
1.E+17
1.E+16
1.E+15
1.E+14
0
1
2
3
4
5

[図5]

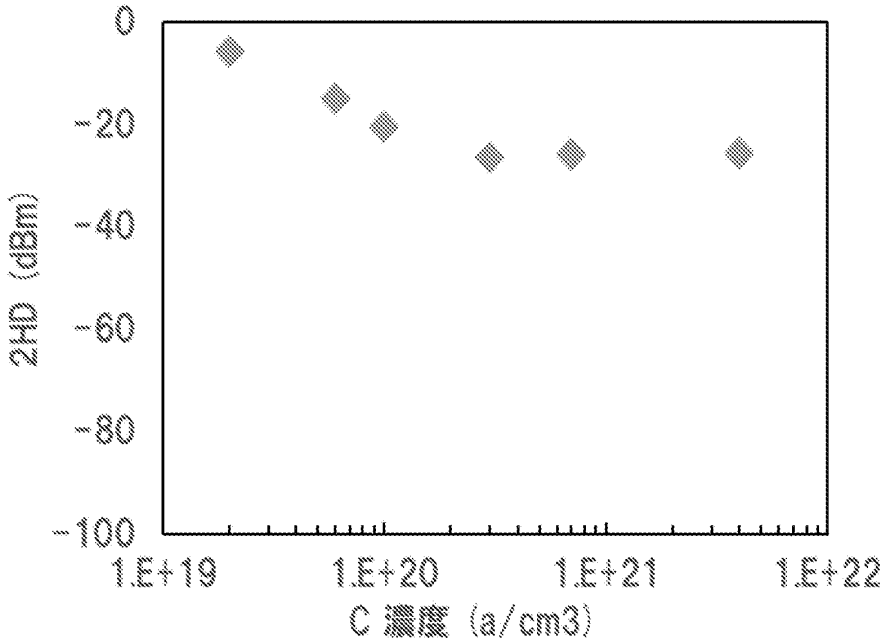
1'


4
3'
2

[図6]


600
500
400
300
200
100
0
V_{BD} (V)
0.00E+00
2.00E+20
4.00E+20
6.00E+20
8.00E+20
1.00E+21
C Concentration (atoms/cm^3)

[図7]


0
-20
-40
-60
-80
-100
2HD (dBm)
1.E+19
1.E+20
1.E+21
1.E+22
C 濃度 (a/cm3)